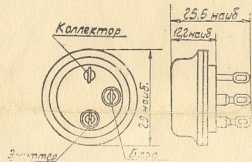


# A-500



## по Ге3.365.003ТУ



### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

при  $t$  корпуса  $+20 \pm 5^\circ\text{C}$

### ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ

при  $t$  от  $-60^\circ\text{C}$  до  $+150^\circ\text{C}$  на переходе

№ п.п.	Наименование параметров	Обозначен.	Един. измер.	Знач. реж.	Прим.
1	Ток коллектора	Ik	а	3	1
2	Ток базы	Iб	а	1,5	
3	Напряжение коллектор-эмиттер при $R_{эб}=10$ ом	Uкэ	в	120	1,2
	Постоянное		в	250	1,2,3
	Импульсное		в	3	1
4	Обратное напряжение эмиттер-база	Uбэ	в	3	1
5	Мощность, рассеиваемая на коллекторе при $t$ корпуса $0 \pm 100^\circ\text{C}$	Pк	Вт	10	1
6	Предельная температура корпуса	$t$ кор.	$^\circ\text{C}$	100	1
7	Предельная частота		мг ц	1	1,4

- ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Не должен превышать ни один из других предельно-допустимых эксплуатационных режимов.
  2. При температуре перехода до  $+100^\circ\text{C}$ . При температуре перехода от  $100^\circ\text{C}$  до  $150^\circ\text{C}$  снижается линейно на 10% на каждые  $10^\circ\text{C}$ .
  3. При длительности не более 500 мсек и скважности  $\geq 10$ .
  4. Гарантируется конструкцией.

№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	Обозначение	Единица измерения	Норма		Режим испытания					Схема включения
				не менее	не более	Uк, в	Uэ, в	Iк, а	Iб, а	Rэб, ом	
1	Начальный ток коллектора	Iкн	ма	3	200					10	ов
2	Обратный ток эмиттера	Iэо	ма	50		3					
3	Коэффициент усиления по току	Bct		10	50	3		2,5			
4	Напряжение коллектор-эмиттер в режиме насыщения	Uкн	в	0,1	1,0			2	0,32		
5	Входное напряжение	Uвх	в	2	3			2,5			
6	Начальный ток коллектора при температуре корпуса $+100 \pm 5^\circ\text{C}$ Содержание золота—0,253 мгр. серебра—100,457 мгр.	Iкп	ма	10	200					10	

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 6 мм от корпуса транзистора. При пайке температура корпуса не должна превышать  $+120^\circ\text{C}$ . Пайка проводится паяльником, нагретым до температуры  $250 \pm 10^\circ\text{C}$  в течение времени не более 2—3 секунд.
2. В электрическую цепь, находящуюся под напряжением, базовый контакт транзистора должен присоединяться первым и отключаться последним.
3. При эксплуатации транзисторов в условиях механических воздействий их необходимо крепить за корпус.
4. При конструировании схем следует учитывать возможность самовозбуждения транзистора за счет паразитных обратных связей.
5. За температуру корпуса принимается температура любой точки основания транзисторов.
6. Крепление транзистора к теплоотводу должно обеспечивать надежный тепловой контакт.

Дата выпуска *VI* 1970 г. Начальник ОТК *Иванов*